

Cited reference 4
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number : 2000-056874

(51)Int. Cl.

GD3X 27/616

(21)Application number: 10-219075

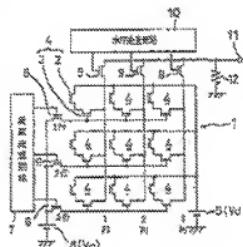
(71)Applicant : HORIBA LTD
(72)Inventor : SAWADA KAZUAKI
MIMURA SUGUMU
TOMITA KATSUHIKO

1543 USEET ARRAY

(57) Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To suppress the influence of a noise due to the turning-on and off of a switch by a method wherein a voltage is always applied to all ion-sensitive field-effect transistors.

SOLUTION: In an ISFET array 1, MOS switches 6 only in a first row and MOS switches 9 only in a first column are turned on by a vertical scanning circuit 7 and a horizontal scanning circuit 10. Therefore, signal currents are output only from unit sensors 4 in which devices are crossed. For example, MOS switches 6 in a first row and MOS switches 9 in a first column are turned on, and signal currents can be fetched from unit sensors 4. A source-drain current is applied, from a power supply 5, to ISFET's 2 in all unit sensors 4 including the unit sensors 4, and all the ISFET's 2 are set always to an operating state. In this manner, since the ISFET's 2 are not turned on and off, a noise due to the switching operation of MOS switches 6, 9 is hardly generated, and its influence can be reduced.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 02.05.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application?]

(Patient number)

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

〔Date of extinction of right?〕

(19)日本特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2000-55874

(P2000-55874A)

(43) 公開日 平成12年2月25日 (2000.2.25)

(51) Int.Cl.⁷
G 0 1 N 27/414

録画装置

F 1
G 0 1 N 27/30

マーク (参考)

3 0 1 X

審査請求 未請求 前項の数 1 O.L. (全 4 頁)

(21) 出願番号 特願平10-219075

(71) 出願人 000155023

株式会社堀場製作所

京都府京都市南区吉祥院宮の東町2番地

(22) 优先日 平成10年8月3日 (1998.8.3)

(72) 発明者 森田 和明

愛知県豊橋市上ヶ崎町宇上原1番地3
合同宿泊会所上ヶ崎住宅1号棟304号室

(72) 発明者 三村 孝

京都府京都市南区吉祥院宮の東町2番地
株式会社堀場製作所内

(72) 発明者 京田 勝彦

京都府京都市南区吉祥院宮の東町2番地
株式会社堀場製作所内

(74) 代理人 100074273

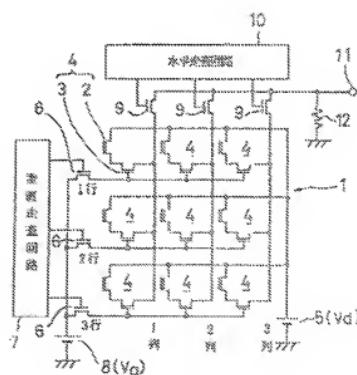
井理士 厳本 英夫

(54) 【発明の名稱】 ISFETアレイ

(57) 【要約】

【課題】 スイッチのオン、オフによるいわゆるノイズの影響を可及的に少なくしたISFETを提供すること。

【解決手段】 ISFET2を二次元的に複数個配置してなるISFETアレイ1において、全てのISFET2に常に電圧を印加し、全てのISFET2を常に動作状態にしている。



1-ISFETアレイ

2-ISFET

【特許請求の範囲】

【請求項1】 I-SFETを二次元的に複数個配置してなるI-SFETアレイにおいて、全てのI-SFETに常に電圧を印加し、全てのI-SFETを常に動作状態にしてあることを特徴とするI-SFETアレイ。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】この発明は、例えば溶液中のイオン濃度をFEET(電界効果トランジスタ)の中を流れる電流値に変換して測定するI-SFET(イオン感応性電界効果トランジスタ)を構成に複数個配置してなるI-SFETアレイに関するもの。

【0002】

【従来の技術】上記1のI-SFETを二次元的に複数個配置し、且其の二次元分布を測定するものとして、例えば、特公平1-33745号公報に示すような水素イオン濃度分布測定装置がある。図3は、この水素イオン濃度分布測定装置におけるI-SFETアレイの構成を示すもので、このI-SFETアレイは、例えば9つのI-SFET 31～39を3行3列に配置し、これらのI-SFET 31～39を、各行および各列に対応するスイッチ40～45のスイッチング動作により、それぞれの位置のpH情報を電圧信号として取り出すようにしたもので、例えば、スイッチング要素40、43を閉じる(オンする)ことにより、I-SFET 31がオンとなり、これによって、I-SFET 31におけるpH情報が方針端子46にに出力される。なお、図3において、47は電流信号を電圧信号として取り出すための抵抗、48はスイッチングゲート電圧電源である。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】ところで、一般に、I-SFETはオンとなって出力が安定するまで多少の時間がかかるといった性質があるが、上記従来のI-SFETアレイにおいては、スイッチ40～45をオンまたはオフして、特定のI-SFETにおけるpH情報を得ようとした場合、そのI-SFETがオンまたはオフして、その状態が安定せず、このため、その出力信号がスイッチング動作の影響を受け、出力が安定しないという不都合があった。

【0004】この発明は、上述の事柄に留意してなされたもので、その目的は、スイッチのオン、オフによるいわゆるノイズの影響を可及的に少なくしたI-SFETを提供することである。

【0005】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため、この発明は、I-SFETを二次元的に複数個配置してなるI-SFETアレイにおいて、全てのI-SFETに常に電圧を印加し、全てのI-SFETを常に動作状態にしている。

【0006】上記構成によれば、I-SFET自体はオン

オフしてないので、スイッチング動作によるノイズ影響が大幅に低減される。

【0007】

【発明の実施の形態】発明の実施の形態を、図面を参照しながら説明する。図1は、この発明のI-SFETアレイ1の構成を概略的に示すもので、このI-SFETアレイ1は、例えば、溶液中の水素イオン濃度を電流値に変換するI-SFET 2と、このI-SFET 2に直列に接続されるスイッチ素子としてのMOSFET 3とからなる複数の単位センサ(簡素ともいう)4を例えばシリコン基板5(図2参照)の表面5aに二次元的に配置してなるものである。より詳しくは、各単位センサ4において、I-SFET 2のドレインとMOSFET 3のソースとが接続されている。これらの単位センサ4は、例えば3行3列に二次元的に配列されている。そして、各I-SFET 2のソースには、電源5bによって常にソースドレイン電圧(V_{ds})が付与されるように構成されている。

【0008】また、前記MOSFET 3は、各行ごとに

そのゲート同士が互いに接続され、各行に付属して設けられるスイッチ素子としてのMOSスイッチ6のドレインに接続されている。そして、各MOSスイッチ6のゲートは、垂直走査回路7に接続されている。8はMOSスイッチ6のゲートにスイッチングゲート電圧(V_g)を付与する電源で、その正極は各MOSスイッチ6のソースと接続され、負極は接地されている。

【0009】さらに、前記MOSFET 3は、各列ごとに

そのドレイン同士が互いに接続され、各列に対応して設けられるスイッチ素子としてのMOSスイッチ7のソースに接続されている。そして、各MOSスイッチ7のゲートは、水平走査回路10に接続されている。また、各MOSスイッチ7のドレイン同士は互いに接続されるとともに、出力端子11に接続されている。12は電流信号を電圧信号として取り出すための回路である。

【0010】上記構成のI-SFETアレイ1においては、垂直走査回路7および水平走査回路10によって、

1行、1列のみのMOSスイッチ7、9をオンすることにより、装置の交叉している単位センサ4のみから信号電流が放出される。例えば、図1において、1行目と1列目のMOSスイッチ7、9をオンすることにより、左上の単位センサ4から信号電流を取り出すことができる。この場合、当該単位センサ4を含む全ての単位センサ4におけるI-SFET 2には、電源5bによってソースドレイン電圧V_{ds}が印加されており、全てのI-SFET 2は常に動作状態になっている。つまり、I-SFET 2自体はオン、オフしていないので、MOSスイッチ7、9のスイッチング動作によるノイズが殆どなくなり、その影響が大幅に低減される。

【0011】そして、上記構成のI-SFETアレイ1においては、I-SFET 2に直列に接続されるスイッチ7としてMOSスイッチを用いているので、I-SFET 2

レイ1全体の構成が簡単になる。

【0012】図2は、前記1-SFETアレイ1を用いたpH二次元分布測定装置13によってトロイの分離を測定する状態を概略的に示す図で、この例において、14は被検体としての寒天である、そして、この寒天14の表面に、1-SFETアレイ1が形成された基板15の表面1aが密着している。15は寒天14に挿入される比較電極である。16は1-SFETアレイ1の出力と比較電極15の出力との差をとる電圧計で、その出力は演算制御部としての画像処理可能なコンピュータ17に入力される。このコンピュータ17は、前記垂直走査回路7および水平走査回路10に流入され、

この走査回路7と10によって、寒天14の表面を走査する。この走査回路7と10は、コンピュータ17から垂直走査回路7および水平走査回路10に逐次制御信号を送り、MOSスイッチ6、9を順次オンオフ制御することにより、寒天14におけるpHの二次元分布を測定することができる。そして、このとき得られる信号を直通画像処理することにより、pHの二次元分布画像を得ることができる。この場合、1-SFETアレイ1においては、上述したようにスイッチノイズの影響をほとんど受けないことで、高画質の二次元画像化を行うことができる。

【0014】この発明は、上述の実施の形態に限られるものではなく、1-SFETアレイ1としては、単位センサ4をn×n (nは自然数)配置にしたもののみなら

ず、m×n (mは自然数)であってもよい。

【0015】そして、1-SFET2に直列に接続されているMOSスイッチ3に代えて、オペアンプなどの応用電子回路を用いてもよい。このようによることにより、個々の1-SFET2の特性の補正、出力電流の増幅、電流電圧変換などを随時行うことができる。特に、早い段階において増幅することによりS/Nを大きくすることができます。信号精度を向上させることができる。

【0016】また、1-SFET2としては、水溶イオン以外の他のイオンに応答するものであってもよいことはいうまでもない。

【0017】

【発明の効果】この発明の1-SFETアレイにおいては、1-SFETアレイを構成する全ての1-SFETに常に電圧を印加し、全ての1-SFETを常に動作状態にしているので、スイッチング動作によるノイズ影響を受けることがなくなり、精度の高い測定を行なうことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の1-SFETアレイの構成を概略的に示す図である。

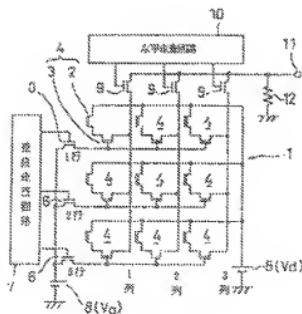
【図2】前記1-SFETアレイを用いたpH二次元分布測定装置の一例を概略的に示す図である。

【図3】従来の1-SFETアレイを示す図である。

【符号の説明】

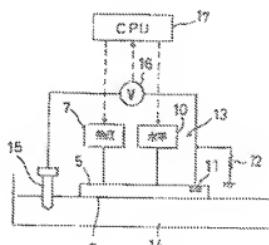
1…1-SFETアレイ、2…1-SFET

【図1】



1…1-SFETアレイ
2…1-SFET

【図2】



(4) 断2000-55874 (P2000-55874A)

【図3】

